

	<p><b>SI9435BDY-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI9435BDY-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 4.1A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI9435BDY-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 55936 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9435BDY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 4.1A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	55936 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 5.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI9435BDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI9435BDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9435BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9435BDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI9435BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9435BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9435BDY-T1-E3</b> VISHAY SI9435BDY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI9435DY</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 5.3A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI9435BDY-T1</b> VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p><b>SI9435AN</b> SI SI9435AN SI</p>	 <p><b>SI9435ADY-T1-GE3</b> VISHAY SI9435ADY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI9435BDY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.1A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI9433ADY-T1-GE3	↔ SI9433BDY-T1-E3	➔ SI9433BDY-T1-E3	D SI9433BDY-T1-GE3	➔ SI9433BDY-T1-GE3
⊣ SI9433DY	⊛ SI9433DY-T-E3	D SI9433DY-T1	➔ SI9433DY-T1-E3	➔ SI9433DY-T1-E3.
⊛ SI9433DY-T1-GE3	⊣ SI9433DY-T1	⊛ SI9434ADY-T1-E3	↔ SI9434BDY-T1-E3	➔ SI9434BDY-T1-E3
D SI9434BDY-T1-GE3	⊛ SI9434BDY-T1-GE3	⊣ SI9434DY	⊛ SI9434DY-T1	➔ SI9434DY-T1-E3
➔ SI9434DY-T1-GE3	↔ SI9435ADY	⊛ SI9435ADY-T1-E3	⊣ SI9435ADY-T1-GE3	➔ SI9435BDY-T1-E3
↔ SI9435BDY-T1-GE3	➔ SI9435BDY-T1-GE3	D SI9435DY	⊛ SI9435DY	⊣ SI9435DY-NL
⊛ SI9435DY-T1-E3	D SI9435DY-T1-E3.	➔ SI9435DY-T1-GE3	↔ SI9436DY-T1	➔ SI9436DY-T1-E3
⊣ SI9436DY-T1-GE3	⊛ SI9706DY	↔ SI9706DY-E3	➔ SI9706DY-E3	➔ SI9706DY-T1
⊛ SI9706DY-T1-E3	⊣ SI9706DY-T1-E3	⊛ SI9710CY	D SI9711CY	➔ SI9711CY-T1-E3
↔ SI9712DY	⊛ SI9712DY-T1	⊣ SI9712DY-T1-E3	⊛ SI9712DY-T1-E3	➔ SI9712DY-T1

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited